







 	<h2>RQ3E080BNTB</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: RQ3E080BNTB</p> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 8A HSMT8</p> <p>Datenblätter:  RQ3E080BNTB.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 8099 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	RQ3E080BNTB
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 8A HSMT8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	8099 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	150 °C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Supplier Device-Gehäuse	8-HSMT (3.2x3)
Verlustleistung (max)	2W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	15.2 mOhm @ 8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	660pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

RQ3E080BNTB ist neu im Original, Suche RQ3E080BNTB Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie RQ3E080BNTB LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage RQ3E080BNTB: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>RQ3E075ATTB LAPIS Semiconductor PCH -30V -18A MIDDLE POWER MOSFE</p>	 <p>RQ3E080BNFU7 LAPIS Semiconductor RQ3E080BNFU7 ROHM/</p>	 <p>RQ3E070BNTB LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 30V 7A HSMT8</p>	 <p>RQ3E100BNFU7 LAPIS Semiconductor RQ3E100BNFU7 ROHM/</p>
 <p>RQ3E080BNFU7TB ROHM RQ3E080BNFU7TB ROHM</p>	 <p>RQ3E100BNFU7TB ROHM RQ3E100BNFU7TB ROHM</p>	 <p>RQ3E100BN QQ2850920316 RQ3E100BN QQ2850920316</p>	 <p>RQ3E080GNTB LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 30V 8A 8-HSMT</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ F25L008A-100	↔ KA7818ETU	⇒ LM4040DIM7-4.1	D MX7224LCWN	⇒ R2A20117
⊣ RQ3E070BN	⊗ RQ3E070BNFU7	D RQ3E070BNFU7TB	⇒ RQ3E070BNTB	⇒ RQ3E080BN
⊗ RQ3E080BNFU7	⊣ RQ3E080BNFU7TB	⊗ RQ3E080GN	↔ RQ3E080GNTB	⇒ RQ3E100BN
D RQ3E100BNFU7	⊗ RQ3E100BNFU7TB	⊣ RQ3E100BNTB1	⊗ RQ3E100GN	⇒ RQ3E100GNFU7TB
⇒ RQ3E100GNTB	↔ RQ3E100MN	⊗ RQ3E100MNFU	⊣ RQ3E100MNTB	⇒ RQ3E110AJ
↔ RQ3E120AT	⇒ RQ3E120AT-TB	D RQ3E120BN	⊗ RQ3E120BNFU7TB	⊣ RQ3E120GN
⊗ RQ3E120GNTB	D RQ3E130BN	⇒ RQ3E130BNFU7TB	↔ RQ3E130MNTB	⇒ RQ3E130MUTB
⊣ RQ3E13BNFU7	⊗ RQ3E150BN	↔ RQ3E150BNFU7	⇒ RQ3E150GN	⇒ RQ3E150MN
⊗ RQ3E150MNFU7TB1	⊣ RQ3E150MNTB	⊗ RQ3E160AD	D RQ3E160ADM6	⇒ RQ3E160ADTB1
↔ RQ3E180BN	⊗ RQ3E180GN	⊣ RQ3G100GN	⊗ T491B107K006AT	⇒ TL431ACPKG3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited